



中华人民共和国国家标准

GB/T 6621—1995

硅抛光片表面平整度测试方法

Test methods for surface flatness of silicon polished slices

1995-04-18 发布

1995-12-01 实施

国家技术监督局 发布

硅抛光片表面平整度测试方法

代替 GB 6621—86

Test methods for surface flatness of silicon polished slices

第一篇 方法 A——光干涉法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用相干光的干涉现象测量硅抛光片表面平整度的方法。

本标准适用于检测硅抛光片的表面平整度,也适用于检测硅外延片和类镜面状半导体晶片的表面平整度。

2 术语

2.1 总指示读数(TIR) total indicator runout (TIR)

两个与基准平面平行的平面之间的最小垂直距离。处于晶片正面的固定优质区(FQA)或局部优质区域内的所有的点在两平行平面的范围内。又称最大峰——谷差(见图 1)。

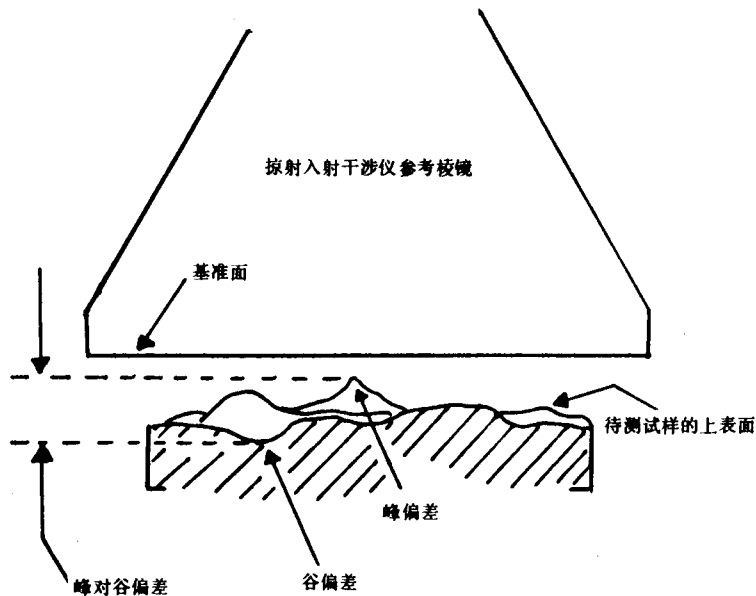


图 1 晶片计量学定义

注:峰和谷的位置可能出现在试样表面的任何地方。

2.2 焦平面 focal plane